日程表(会場別1)

	後							::00 /全般			13:30~16:30 15.7 結晶評価,不純物·結晶 欠陥	::45 頁微鏡		13:45 ~ 17:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デ パイス技術	13:00 ~ 16:45 21.1 合同セッションK 「ワイド ギャッブ酸化物半導体材料・デバ イス」	14:15 ~ 17:15 15.4 III-V族窒化物結晶	::30 用光学		13:00~17:15 CS.6 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新 技術のコードシェア
2022年3月26日(土)								13:00~16:00 3.9 テラヘルツ全般			13:30~16 15.7 結晶評 欠陥	13:30 ~ 16:45 6.6 プローブ顕微鏡				14:15 ~ 17:15 15.4 III-V族窒1	13:00~16:30 3.4 生体·医用光学		13:00~17:15 CS.6 6.5 表面物 原子・分子線およ 技術のコードシェア
	世							9:30 ~ 11:00 3.9 テラヘルツ全般	9:00 ~ 10:30 17:1 カーボンナノチューブ, 他の ナノカーボン材料	9:00 ~ 11:30 13.3 絶縁膜技術	9:00~12:00 15.7 結晶評価,不純物·結晶 欠略	9:00 ~ 12:00 6.6 プローブ顕微鏡		9:00 ~ 12:15 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デ パイス技術	9:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションド 「ワイド ギャッブ酸化物半導体材料・デバイス」	9:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00~11:30 3.4 生体·医用光学	9:00 ~ 11:30 3.2 材料・機器光学	10:30 ~11:45 6.5 表面物理·真空
2022年3月25日(金)	4後	13:00 ~ 14:15 15.2 II-V族結晶おむ多元系 結晶	13:00 ~ 17:15 15:5 IV族結晶, IV-IV族混晶		13:30 ~ 17:00 3.5 レーザー装置・材料	13:00 ~ 18:00 3.9 テラヘルッ全般	13:00 ~ 16:45 3.6 超高速·高強度レーザー	13:30 ~ 17:25 T21 2050年カーボンニュートラ ル:これから何をすべきなのか?	13:30 ~ 18:30 17.2 グラフェン	13:30 ~ 16:50 T16 生産現場における10デバイ ス技術活用の最新動向	13:00 ~ 18:30 8.2 ブラズマ成職・エッチング・表 面処理	13:30 ~ 17:15 8.4 プラズマライフサイエンス		13:30 ~ 17:15 T12 スピントロニクスによるグリーン イノベーション	13:30 ~ 17:30 21.1 合同セッション K 「ワイド ギャッ丁酸化物 半導体材料・デバ イス」	13:30 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:15 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 17:15 12.1 作製·構造制御	13:30 ~ 16:00 12.5 有機太陽電池
	世 十	9:00 ~ 12:00 2.4 医用応用	9:30 ~ 11:15 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		10:00 ~ 11:30 3.5 レーザー装置・材料	9:00 ~ 11:30 3.4 牛体·医用光学	9:00 ~ 11:30 3.6 超高速·高強度レーザー		9:45 ~ 11:00 17.3 層状物質 11:15 ~ 12:00 17.2 グラフェン	9:30 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・ MEMS・装置技術	9:00 ~ 12:00 8.2 ブラズマ成膜・エッチング・表 面処理	: 9:30 ~ 11:45 8.4 プラズマライフサイエンス		9:00 ~ 12:00 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ ストレージ技術	9:30 ~ 12:00 21.1 合同セッション K 「ワイド ギャッブ酸化物半導体材料・デバ イス」	9:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 12:00 6.2 カーボン系薄膜	9:30 ~ 12:00 12.1 作製·構造制御	9:30 ~ 12:00 12.5 有機太陽電池
2022年3月24日(木)	大後	13:00 ~18:00 1.5 計測技術·計測標準	13:00 ~ 16:15 8.3 プラズマナノテクノロジー	13:00 ~ 16:00 3.16 Optics and Photonics Enalish Session	13:00 ~ 14:45 CS.2.3.5 レーザー装置・材料、 3.14 光制御デバイス・光ファイ バーのコードシェア	13:00 ~ 16:153.6 超高速・高強度レーザー		13:30 ~ 18:05 T20 量子コンピュータ: システム 構築のための技術と期待されるア ブリケーション(II)	13:30 ~ 18:15 17.1 カーボンナノチューブ,他の ナノカーボン材料	13:30 ~ 18:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・ MEMS・装置技術	13:00 ~ 17:45 CS:8 12:6 ナソバイオテクノロジ・、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア	13:30 ~ 17:00 CS.5 6.1 強誘電体薄膜 13.3 絶縁膜技術 13.5 デバイス/配 線/集積化技術のコードシェア	13:30 ~ 18:30 3.7 レーザープロセシング	13:30 ~ 17:35 T7 オンライン時代の機能性マテリ アル ~beyond5G/6Gに向けて ~	13:30 ~ 15:30 7.1 X繰技術 16:00 ~ 18:30 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ ストレージ技術		13:30 ~ 16:15 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 18:30 9.4 熱電変換	13:30 ~ 16:45 12.5 有機太陽電池
	年前 9:30 ~ 10:45	8.5 ブラズマ現象・新応用・融合 分野 10:45 ~ 11:00 8.6 Plasma Electronics English Session		9:00 ~ 10:30 11.4 アナログ応用および関連技 術		9:00 ~ 11:30 3.6 超高速・高強度レーザー	5.7 8.3 ブラズマナン 5.7 8.3 ブラズマナン ランナン粒子・ナシート、13.6 ナノ様沿 キ・ナノ量子デバイス :: 族エピタキシャル結晶 ケーの基礎のコードシェ	10:00 ~ 11:45 7.1 X線技術	9:00 ~11:45 17.3 層状物質	9:00 ~ 12:30 13.4 SI系プロセス・SI系薄膜・ MEMS・装置技術	- ≿⊡ <i>\</i> r	9:00 ~11:45 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセシング	9:30 ~ 11:40 NT1 就活生必見! カーボンニュー トラルは半導体が切り拓く	9:15 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~11:45 23.1 合同セッションN「インフォマ ティクス応用 I	9:30 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00 ~ 12:00 9.4 熱電変換	9:00 ~12:15 12.5 有機太陽電池
2022年3月23日(水)	午後	13:00~18:15 1.6 超音波	13:00 ~ 16:05 12.3 機能材料・萌芽的デバイス		13:30 ~ 18:00 11.1 基礎物性	13:00 ~ 17:45 3.3 情報フォトニクス・画像工学	liH	13:30 ~ 17:30 T18 一次元・二次元融合物質 系:ナノチューブ・原子層・ヘテロ 積層の科学	13:30 ~ 17:15 FS:1 フォーカストセッション「AII レクトロニクス」	13:30~18:05 T10 プラズマ・液体相互作用~ 基礎と応用の最新動向	13:00 ~ 17:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:45 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:45 13.9 化合物太陽電池	13:15 ~ 16:30 T11 トポロジカレ材料科学の拓く 新機能・新物性	14:15 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 16:15 11.3 臨界電流,超伝導パワー 応用	13:30 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 18:30 10.4 半導体・トポロジカル・超伝 導・強相関スピントロニクス	13:30 ~17:00 12.4 有機EL・トランジスタ
	大艶 (9:00 ~ 11:00 11.4 アナログ応用および関連技 術	9:00 ~11:45 11.2 薄膜,厚膜,テープ作製 プロセスおよび結晶成長	9:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎·光学新領域		9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	9:00~11:30 FS:1 フォーカストセッション「AII レクトロニタス」	9:15 ~ 12:00 8.5 ブラズマ現象・新応用・融合 分野	9:00 ~ 11:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	9:30 ~ 11:40 T11 トポロジカル材料科学の拓く 新機能・新物性	9:15 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00~12:00 17.1 カーボンナノチューブ,他の ナノカーボン材料	9:00 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:15 ~ 12:00 10:1 新物質·新機能創成 (作製・評価技術)	9:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ
2022年3月22日(火)	午後			13:00 ~ 17:00 9.5 新機能材料·新物性	13:00 ~ 16:00 3.14 光制御デバイス・光ファイ バー	13:00 ~ 17:45 3.1 光学基礎·光学新領域	13:00 ~ 17:15 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 16:15 T19 応用物理におけるインフォマ ティクス応用の最前線	13:30 ~ 17:30 FS:1 フォーカストセッション「AII レクトロニクス」	9:00 ~ 11:15 13:30 ~ 16:25 13:12 ナノ領域光科学・近接場光 T4 蛍光体エネルギー移動エンジ 学 ニアリンガ	17:00 ~ 18:20 研究分野業績賞、光・量子エルク トローフ入業績賞、化合砂半導体 エレクローク入業績賞、な性研究 者研究業績・人材育成賞、光工学功績論授賞式		13:30 ~ 18:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	13:30 ~ 17:25 T6ブローブ顕微鏡を用いたナノス ケール化学分光の最前線	13:30 ~ 18:15 15.4 III-V族窒化物結晶		13:30 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:45 ~ 18:15 10.1 新物質·新機能創成(作製·評価技術)	13:30 ~ 17:15 12.4 有機EL・トランジスタ
	4年			9:45 ~ 11:30 9.5 新機能材料・新物性	9:00 ~ 11:30 3.14 光制御デバイス・光ファイ バー	10:00 ~ 11:30 3.1 光学基礎·光学新領域	9:30 ~ 11:15 13.8 光物性・発光デバイス	10:00 ~ 12:00 T19 応用物理におけるインフォマ テイクス応用の最前線	9:00 ~ 11:15 FS.1 フォーカストセッション「AII レクトロニクス」	9:00 ~ 11:15 3.12 ナノ領域光科学・近接場光 学	11:00 ~ 12:00 APEX/JJAP編集買耐賞、論文 賞、講演奨励賞授賞式	9:30 ~ 11:30 13.1 Si系基礎物性・表面界面・ シミュレーション	9:00 ~ 10:00 1.4 1ネルギー変換・貯蔵・資 源・環境		10:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	9:30 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00 ~ 12:15 10.5 磁場応用	10:30 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ
松容		3 144	4 144	144	144	5 144	144	1 357	2 303	303	210	210	5 210	1 357	2 303	303	210	210	5 210
4 計分	1	D113	D114	D214	D215	D315	D316	E101	E102	E103	E104	E105	E106	E201	E202	E203	E204	E205	E206

日程表(会場別2)

		Ϋ́Z	總	借·現象	봳	77			紫細構造形		易電池		
2022年3月26日(土)	午後	13:30 ~ 17:00 3.13 半導体光デバイス	13:30~17:00 3.8 光計測技術・機器	13:30~16:15 3.11 フォトニック構造・現象	13:30~16:30 12.2 評価·基礎物性	13:00 ~ 15:00 9.3 ナノエレクトロニクス	13:30~16:00 1.2 教育		13:00 ~ 14:00 7.3 微細パターン・微細構造形成技術		13:30 ~ 16:30 16.3 シリコン系太陽電池		
	午前	9:30 ~ 12:(3.13 半導体	9:00 ~12:00 3.8 光計測技術・機器	9:15 ~ 12:00 3.11 フォトニック構造・現象	9:15 ~ 11:45 12.2 評価·基礎物性	9:00 ~ 11:15 9.3 ≠ノエレクトロニクス	9:00 ~11:30 9.1 誘電材料・誘電体		9:00 ~ 11:15 7.2 電子ビーム応用	9:00 ~ 10:00 16.2 エナジーハーベスティング	9:30 ~12:00 16.3 シリコン系太陽電池	[09:30-11:30] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.1. 教育 8 プズマエレクトロニクス 12.1 作製・構造制御	15.5 IV族結晶,IV-IV族混晶
2022年3月25日(金)	午後	13:00~15 CS.9 13.7 4 パイス・プロセス IV族系化合物 シェア	13:15~18:30 3.8 光計測技術・機器	13:30~17:15 3.11 フォトニック構造・現象	13:45~18:00 12.2 評価·基礎物性	13:30~18:30 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 17:30 13.5 デバイス/配線/集積化 技術	13:30 ~ 18:00 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 15:45 CS.12.3 加速器質量分析・加速器でロム分析、ア5 イオンビーム一般のコードシェア	13:00~17:15 2.5 放射線誘起蛍光体	13:00~17:15 15.1 / 小分結晶成長	[13:30-15:30] 6.3 酸化物工レクトロニクス 6.5 表面物理,真空 6.6 ブローブ顕微鏡 13.3 絶縁腹技術 15.7 結晶評価,不純物·結晶 欠陥	[16:00-18:300] 3.2 材料、機器化学 3.4 生体、医用光学 3.13 半導体光デバイス 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナンシート
	午前	9:00 ~ 11:30 CS.9 13.7 化合物及がワーデ バイス・プロセス技術・評価、15.6 IV族系化合物(SiC)のコード シェア	9:00 ~ 11:35 3.8 光計測技術・機器	9:30 ~ 12:00 CS.4 3.11 フォトニック構造・現 象、3.13 半導体光デバイスの コードシェア	9:00 ~11:30 12.2 評価·基礎物性	9:00 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜		9:15 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	10:30 ~ 11:30 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器だーム分析、7.5 イオンビーム一般のコードシェア			[09:30-11:30] 1.5 計測技術・計測機準 9.1 誘電材料・誘電体 12.6 サンパイオテクロジー 12.7 医用工学・バイオテグ 15.1 バルが高限点	23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」
_	午後	13:30 ~ 16:55 T1 SDGs を意識した物理教育 を目指して	9:00 ~ 12:30 CS-9 13.7 化合物及び(ワーデ //ス・プロセス技術・評価、15.6 //ス・プロセス技術・評価、15.6 //ス・プロセス技術・評価、15.6 //ス・プロセス技術・評価、15.6 //ス・プロモス技術・評価、15.6 //ス・プロモス技術・評価、15.6 //ス・プロモス技術・評価、15.6 //ス・プロモス技術・評価、15.6 //ス・プロモス技術・評価、15.7 // フェア・フェア・フェア・フェア・フェア・フェア・フェア・フェア・フェア・フェア・	13:15 ~ 16:00 CS.3 3:11 フォトニック構造・現 家、3.12 ナノ領域状科学・近接 場光学のコードシェア 16:15 ~ 17:45 学	13:00 ~17:45 T15 二次元材料を集積回路 に!	13:30~18:00 NT2 ジェンダード・イノベーションを 通して考える応用物理の男女共 同参画	13:30 ~ 16:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 17:15 T3 放射線誘起蛍光体の基礎と 応用	13:30 ~ 16:30 CS.1 2.3 加速器質量分析・加 速器ビーム分析、7.5 イオンビー ム一般のコードシェア	13:15 ~ 18:00 22.1 合同セッションM 「フォノンエ ンジニアリング」	13:00 ~16:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシー ト	[13:30-15:30] 10 スピントロニクス・マグネティクス 12.2 評価 - 基礎が性 13.9 化合物太陽電池 15.4 III-V族窒化物結晶	[16:00-18:00] 3.5 レーザー装置・材料 3.8 光計測技術・機器 3.9 デラヘルツ全般 3.10 光量子物理・技術
2022年3月24日(木)	午前	9:15 ~ 12:0 3.11 7≯ トニ	9:00 ~ 12:30 CS.9 13.7 化合物及がプーデ バイス・プロセス技術・評価、15.6 IV族系化合物 (SIC) のコード シェア	9:00~12:00 3.12 才/領域光科学·近接場光学		09:00 ~ 12:10 チュートリアル(有料): スピントロ ニクス入門	9:00 ~ 11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:15 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料		9:15 ~ 12:00 22.1 合同セッションM 「フォノンエ ンジニアリング」	9:00 ~ 11:15 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシー ト	[09:30-11:30] 2 放射線	
2022年3月23日(水)	午後	13:30 ~ 17:40 T17 結晶シリコン太陽電池技術 の今後ペカーポンニュートラル実現 に向けて~	9:00~12:00 CS-913.7 化合物及が(ワーデ //イス・プロセス技術・評価、13.6 /イス・プロセス技術・評価、15.6 /V族系化合物 (SiC) のコード /V族系化合物 (SiC) のコード >シェア	9:00 ~ 12:00 3.12 才/領域光科学·近接場光 3.12 才/領域光科学·近接場光 学	13:30 ~ 16:45 T5 レーザープロセシング技術×AI の最新研究動向	13:30 ~ 18:05 TR ダイヤモンドNV センタを用いた 固体量子センサの最新研究動向	13:30 ~19:00 13.5 デバイス/配線/集積化 技術	13:00 ~ 16:15 T2 放射線分野における機械学 習の利用	13:15 ~ 17:00 13.2 探索的材料物性·基礎物 性			[13:30-15:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.14 光制御デバイス・光ファイ トーリンフォトニクス・集積 フォトニクス 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.4 薄膜折形は 15.3 III・V族エピタキシャル結 晶・エピタキシーの基礎	[16:00-18:00] 9.5 新機能材料・新物性 12.4 有機EL・トランジスタ 12.5 有機太陽電池 13.1 S系基礎物性・表面界面・ ジェコレーション
	牛前			9:00 ~ 12:00 3.12 才/領域光科学·近接楊光 学	9:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセシング	09:00 ~ 11:30 チュートリアル(有料): ダイヤモン ドNV量子センサと量子計測の基 礎と展開	9:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化 技術	9:00 ~ 11:30 2.2 放射線物理一般・放射線応 用・発生装置・新技術	9:00 ~ 11:45 13.2 探索的材料物性·基礎物性	9:00 ~ 11:15 15.3 III-V族エピタキシャル結 晶・エピタキシーの基礎	9:00 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・ デバイス	[09:30-11:30] 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 13.8 光物性・発光デバイス	
_	午後	13:30 ~ 16:45 T14 多元化合物の光機能・エネ ルギー変換材料としての魅力	13:45 ~ 18:30 CS.9 13.7 化合物及がパワーデ 13.7 化合物及びパワーデバイス・パイス・プロセス技術・評価、15.6 プロセス技術・評価 IV蒸ぶ化合物 (SIC) のコード >: T7	13:30 ~ 17:15 3.15 シリコンフォトニクス・集積 フォトニクス	13:30 ~ 17:00 T9 可視光からX線によるイメージ ング -その汎用性の探求-	技術	13:30 ~ 17:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 16:15 2.2 放射線物理一般·放射線応 用·発生装置·新技術	繏	13:00 ~ 17:15 1.1 応用物理一般·学際領域	13:00 ~ 16:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・ デバイス	[13:30-15:30] 3.12 ナ/領域状科学・近接場光 学 13.6 ナ/構造・量子現象・ナ/量 子デバイス 17 ナノカーボン	[16:00-18:00] 7 ビーム応用 13.2 探索的材料物性・基礎物性
2022年3月22日(火)	午前	光機能・エネ・ての魅力	9:00 ~ 12:15 13.7 化合物及びパワーデパイス・ プロセス技術・評価	9:30 ~ 12:00 3.15 シリコンフォトニクス・集積 フォトニクス	9:00 ~ 11:35 T9 可視光からX線によるイメージ ング -その汎用性の探求-	09:00 ~ 11:30 チュートリアル(有料): プラズマプ ロセスと情報工学の融合	9:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス		9:15 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発		9:00 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・ デパイス		3.3 情報フォトニクス・画像工学11 超伝導
	一人数	357	303	303	210	210	210	144	144	144	144	ポ ∀ ∅ − カッ、	y m y
♦	H-30-1	E301	E302	E303	E304	E305	E307	F307	F308	F407	F408	デリーナ P01 ~ P16	